Анизотропия спектров спин-волнового резонанса при диссипативном механизме закрепления спинов

© А.М. Зюзин, С.Н. Сабаев, В.В. Радайкин, А.В. Куляпин

Мордовский государственный университет, 430000 Саранск, Россия

(Поступила в Редакцию 14 мая 2001 г. В окончательной редакции 6 августа 2001 г.)

Экспериментально и теоретически исследованы механизмы, приводящие к анизотропии дисперсионных кривых спектров спин-волнового резонанса в многослойных магнитных пленках. Показано, что одна из причин существенного увеличения угла наклона дисперсионных кривых при промежуточных между перпендикулярной и параллельной ориентациями постоянного магнитного поля **H** относительно пленки связана с изменением равновесной ориентации намагниченности. Установлено, что дополнительное влияние (кроме доминирующего диссипативного механизма закрепления спинов, реактивных или дисперсивных свойств слоя с сильным затуханием) приводит к изменению волновых чисел стоячих спиновых волн и обусловливает рассогласование дисперсионных кривых при перпендикулярной и параллельной ориентациях **H**.

Спектры спин-волнового резонанса (СВР) позволяют получить большой объем информации о физических параметрах магнитных пленок [1–4]. Кроме того, спектры весьма чувствительны к характеру их пространственного распределения, что позволяет путем анализа эволюции спектра, происходящей при уменьшении толщины пленки послойным стравливанием, определить это распределение [5-7]. Наряду с такими параметрами спектра СВР, как резонансные поля линий спин-волновых (СВ) мод, их число, интенсивность и ширина, важной информационной характеристикой является дисперсионная кривая [8-10], по углу наклона которой можно, в частности, определить константу обменного взаимодействия А. Необходимым условием при этом является достоверная идентификация пиков поглощения СВ мод и знание их волновых чисел, что далеко не всегда является легко и однозначно решаемой задачей.

Известно, что спектры СВР, возбуждение которых обусловлено динамическим механизмом закрепления спинов или поверхностной анизотропией, являются сильно анизотропными [2–5,10]. В зависимости от направления постоянного магнитного поля **H** гармонические стоячие спиновые волны возбуждаются в разных областях (слоях) пленки. Это приводит к ярко выраженной модификации спектра СВР при изменении направления **H**. В частности, при совпадении полей однородного резонанса в слоях спектр трансформируется в одиночную общую нулевую моду.

Диссипативный механизм закрепления спинов [8,11–13] проявляется в многослойных пленках с сильно различающимися значениями параметра затухания в слоях и в отличие от отмеченных выше не зависит от направления **H**, т.е. является изотропным. Это обусловлено тем, что, во-первых, область возбуждения гармонической части стоячей спиновой волны при любом направлении **H** относительно пленки ограничена слоем с малым затуханием и, во-вторых, параметр затухания в пленках феррит-гранатов не зависит от направления **H**. Как следует из многочисленных экспериментальных результатов авторов настоящей работы, а также литературных данных, возможная анизотропия параметра затухания Гильберта $\alpha = \Delta H \gamma / \omega$ (здесь ΔH — полуширина линии поглощения, γ — гиромагнитное отношение, ω — круговая частота СВЧ поля) не превышает погрешности измерений, составляющей < 6%. Вместе с тем и в этом случае наблюдается существенная зависимость угла наклона дисперсионной кривой от ориентации постоянного магнитного поля **H** относительно пленки. Поэтому цель настоящей работы состояла в исследовании механизмов, определяющих угол наклона дисперсионных кривых спектров СВР в многослойных пленках при диссипативном механизме закрепления спинов.

1. Эксперимент

Экспериментальные исследования проводились на двух- и трехслойных монокристаллических пленках ферритов-гранатов. Пленки были получены методом жидкофазной эпитаксии путем последовательного наращивания слоев на подложки из гадолиний-галлиевого граната с ориентацией (111) из различных растворов в расплаве. Ближний к подложке слой (слой закрепления) имел состав (SmEr)₃Fe₅O₁₂ и обладал большим значением $\alpha = 0.2$. Намагниченность насыщения $4\pi M$ составляла 1330 G, эффективное поле одноосной анизотропии $H_k^{\text{eff}} = 96 \,\text{Oe}$, поле кубической анизотропии $H_{k1} = -120 \,\mathrm{Oe}, \ \gamma = 1.38 \cdot 10^7 \mathrm{Oe}^{-1} \mathrm{s}^{-1},$ толщина *h* = 1.2 µm. Следующий слой (слой возбуждения) имел состав $Y_{2.98}$ Sm_{0.02}Fe₅O₁₂, $\alpha = 0.003$, $4\pi M = 1740$ G, $H_k^{\text{eff}} = -1715 \text{ Oe}, H_{k1} = -82 \text{ Oe}, \gamma = 1.76 \cdot 10^7 \text{ Oe}^{-1} \text{s}^{-1}.$ В разных образцах толщина h_1 этого слоя составляла от 0.46 до 0.9 µm. Трехслойные пленки отличались от двухслойных наличием еще одного слоя закрепления. В таких пленках спины закреплены на обеих поверхностях слоя возбуждения (симметричные граничные условия). Регистрацию спектров СВР производили

Рис. 1. Спектры СВР при различных ориентациях **H** для пленки с толщиной слоя возбуждения $h_1 = 0.69 \, \mu$ m.

на частоте 9.34 · 10⁹ Hz. Магнитное поле измеряли с помощью ЯМР магнетометра. Толщину определяли интерференционным методом на однослойных аналогах слоев. Изменение толщины слоя возбуждения производили изменением времени роста, а также химическим травлением. Нахождение осей (100), (111), а также значений H_{k1} производили по методике, описанной в [14]. Отметим, что при регистрации спектров СВР на постоянной частоте СВЧ поля ω в качестве дисперсионной кривой, как правило, принимается зависимость $H_0 - H_n = f(k^2)$ [5,8,9,11], где H_0 и H_n — резонансные поля нулевой и *n*-й CB мод, *k* — волновое число. В этом случае разность $H_0 - H_n$, так же как и частота спиновых волн (при постоянном H), квадратична по k. При построении дисперсионных кривых значения волновых чисел CB мод принимались равными $(n + 1/2)\pi/h_1$ для двухслойных и $(2n+1)\pi/h_1$ для трехслойных пленок [5]. Такая нумерационная схема предполагает, что узел стоячей спиновой волны находится на границе раздела между слоями.

Как было установлено на основании многочисленных экспериментов, при доминирующем действии диссипативного механизма закрепления спинов, когда а в слое закрепления ≥ 0.2 , спектры CBP при перпендикулярной, параллельной и промежуточной ориентациях постоянного магнитного поля относительно пленки не имеют заметных различий в своей структуре (рис. 1). При толщинах слоя возбуждения $h_1 \ge 0.9 \,\mu\text{m}$ дисперсионные кривые при перпендикулярной и параллельной ориентациях Н имеют лишь небольшое рассогласование (относительное различие тангенсов углов наклона) между собой (рис. 2). При уменьшении h_1 дисперсионные кривые при обеих ориентациях остаются линейными, углы их наклона увеличиваются и одновременно происходит возрастание величины рассогласования. Наличие закрепления с обеих сторон слоя возбуждения (трехслойная пленка) приводит к возрастанию примерно в 2 раза величины рассогласования кривых (рис. 3), хотя среднее значение углов их наклона остается примерно таким же, как и для двухслойной пленки.

Во всех исследованных пленках угол наклона дисперсионной кривой, соответствующий спектру СВР при параллельной ориентации **H**, был больше, чем при перпендикулярной. Но еще больший наклон имели дисперсионные кривые при промежуточных между перпендикулярной и параллельной ориентациях **H**, в интервале значений угла θ_H между **H** и нормалью к пленке от ~ 20 до 80°. На рис. 2 и 3 в качестве иллюстрации приведены дисперсионные кривые, соответствующие спектрам СВР для угла θ_H , равного 45°.



Рис. 2. Дисперсионные кривые $H_0 - H_n = f (n + 1/2)^2$ для двухслойных пленок с толщиной h_1 , равной 0.9 и 0.46 μ m: $I - \theta_H = 0, 2 - 90, 3 - 45^\circ$. Точки — эксперимент, линии — расчет.



Рис. 3. Дисперсионные кривые $H_0-H_n = f(n + 1/2)^2$ для двухслойной пленки (внизу) и $H_0 - H_n = f(2n + 1)^2$ для трехслойной пленки (вверху) с толщиной $h_1 = 0.69 \,\mu$ m, обозначения те же, что и на рис. 2. Точки — эксперимент, линии — расчет.

2. Расчет спектров СВР

Для объяснения полученных результатов был проведен расчет спектров СВР и соответствующих дисперсионных зависимостей. Расчет основывался на использовании дисперсионного соотношения [15]

$$\left(\frac{\omega}{\gamma}\right)^{2} = \left[H\cos(\theta_{H} - \theta_{M}) + H_{k}^{\text{eff}}\cos^{2}\theta_{M} - H_{k1}a(\theta_{M}) + \frac{2A}{M}k^{2}\right] \times \left[H\cos(\theta_{H} - \theta_{M}) + H_{k}^{\text{eff}}\cos 2\theta_{M} - H_{k1}b(\theta_{M}) + \frac{2A}{M}k^{2}\right],$$
(1)

где

$$a(\theta_M) = (3 - 16x - 3y)/16, \quad b(\theta_M) = -(x + 3y)/4$$
$$x = (2^{3/2} \sin 2\theta_M - \cos 2\theta_M)/3,$$
$$y = -(2^{5/2} \sin 4\theta_M - 7 \cos 4\theta_M)/9,$$

записанного для слоев возбуждения и закрепления и позволяющего установить связь между волновыми числами в слоях. Значения угла θ_M находились с помощью условия равновесной ориентации намагниченности **M**

$$2H\sin(\theta_H - \theta_M) = H_k^{\text{eff}} \sin 2\theta_M + H_{k1} \left[\frac{1}{12} \sin 2\theta_M + \frac{7}{24} \sin 4\theta_M + \sqrt{2} \sin^2 \theta_M - \frac{4\sqrt{2}}{3} \sin^4 \theta_M \right]. \quad (2)$$

В этих уравнениях θ_M и θ_H — углы между нормалью к пленке и **M** и **H** соответственно, отсчитываемые в плоскости (110) от нормали к пленке [111] по кратчайшему пути в сторону кристаллографического направления [001]. Заметим, что, когда поле **H** ориентировано в плоскости (110), вектор **M** также лежит в этой плоскости.

При расчете были использованы обменные граничные условия, записанные для границ слоя возбуждения

$$\frac{\partial m_1}{\partial z}\Big|_{z=0} = 0, \qquad \frac{m_1}{M_1} = \frac{m_2}{M_2}\Big|_{z=h_1},$$
$$\frac{A_1}{M_1} \frac{\partial m_1}{\partial z} = \frac{A_2}{M_2} \frac{\partial m_2}{\partial z}\Big|_{z=h_1}, \qquad (3)$$

и дополнительные условия, учитывающие затухание спиновой волны в слое с большим значением α (слое закрепления)

$$\frac{2A_1}{M_{01}} \frac{\partial m_{1y}}{\partial z} \bigg|_{z=h_1} + b_{11} \int_{h_1}^{h_1+h_2} m_{2y} dz + b_{12} \int_{h_1}^{h_1+h_2} m_{2x} dz = 0,$$

$$\frac{2A_1}{M_{01}} \left. \frac{\partial m_{1x}}{\partial z} \right|_{z=h_1} + b_{22} \int_{h_1}^{h_1+h_2} m_{2x} dz + b_{21} \int_{h_1}^{h_1+h_2} m_{2y} dz = 0, \quad (4)$$

где

$$b_{11} = H\cos(\theta_H - \theta_M) + H_{k2}^{\text{eff}}\cos 2\theta_M + \frac{i\alpha_2\omega}{\gamma_2},$$

$$b_{22} = H\cos(\theta_H - \theta_M) + H_{k2}^{\text{eff}}\cos^2\theta_M + \frac{i\alpha_2\omega}{\gamma_2},$$

$$b_{12} = -b_{21} = \frac{i\omega}{\gamma_2},$$
(5)

 h_1 и h_2 — толщина слоев возбуждения и закрепления соответственно, ось *z* совпадает с нормалью к пленке.

Такое условие было получено путем интегрирования уравнения движения по области, включающей слой закрепления. Также было использовано соотношение, связывающее действительную и мнинмую части волнового числа в слое закрепления [1]

$$k_2'' = \frac{\alpha_2 \omega M_2}{4\gamma_2 A_2} \frac{1}{k_2'} = \frac{\beta}{k_2'}.$$
 (6)

Пространственная конфигурация спиновой волны в слое возбуждения представлялась гармонической

$$m_1(z) = B_1 \sin k_1 z + B_2 \cos k_1 z, \tag{7}$$

в слое закрепления гармонической и экспоненциально затухающей от границы раздела слоев,

$$m_2(z) = [C_1 \sin k'_2(z - h_1) + C_2 \cos k'_2(z - h_1)]$$
$$\times \exp[-k''_2(z - h_1)].$$
(8)

В этих уравнениях B_i , C_i — постоянные, z = 0 соответствует свободной поверхности слоя возбуждения. Результаты расчета, которые приведены на рис. 2 и 3, хорошо согласуются с экспериментальными данными.

3. Обсуждение результатов

Одна из причин, приводящих к существенному увеличению угла наклона дисперсионных кривых при $20 \leq \theta_H \leq 80^\circ$, обусловлена изменением равновесной ориентации намагниченности **M**, происходящим вследствие изменения величины *H* при регистрации спектра CBP [16]. Степень влияния данного фактора зависит от относительного значения эффективного поля анизотропии $H_k^{\text{eff}}/(\omega/\gamma)$ и наиболее заметна в указанном выше интервале углов θ_H . Однако, как уже было отмечено, в экспериментах наблюдается рассогласование дисперсионных кривых для перпендикулярной и параллельной ориентаций, т.е. тогда, когда **H** направлено вдоль трудного или легкого направлений намагничивания и разориентации между **H** и **M** отсутствует.

Другими возможными причинами анизотропии дисперсионной кривой могут быть: а) анизотропия константы обменного взаимодействия; b) различие магнитодипольного вклада в значения резонансных полей CB мод при различных ориентациях **H**; c) различие в поляризации спиновых волн — круговая при перпендикулярной ориентации и эллиптическая при параллельной; d) поперечная структура волны в первом случае и поперечнопродольная во втором; e) различие в значениях пространственной фазы гармонической спиновой волны на одной или обеих границах слоя возбуждения, которое может быть обусловлено различием конфигураций спиновых волн в слое (слоях) закрепления при одной и другой ориентациях.

Что касается первого предположения, то известно, что пленки ферритов-гранатов не обладают скольконибудь заметной анизотропией константы обменного взаимодействия. Кроме того, нами были проведены дополнительные исследования по выявлению возможной анизотропии А. Указанная анизотропия должна в наибольшей степени проявляться при ориентации М вдоль кристаллографических осей (100) и (111). Поэтому при данных ориентациях М были записаны спектры СВР и построены дисперсионные кривые. При построении кривых учитывали влияние изменения равновесной ориентации намагниченности. Как показал эксперимент, возможная анизотропия А в исследованных пленках не превышает погрешности измерений (3%) и не может объяснить наблюдаемую анизотропию дисперсионных кривых.

Относительно причин, изложенных в пунктах b, c. Величина их возможного вклада в резонансные поля СВ мод может зависеть от длины спиновой волны λ₁ или ее волнового числа $k_1 = 2\pi/\lambda_1$, но для одинаковых значений k_1 не должна зависеть от толщины слоя возбуждения λ₁ или симметрии граничных условий. Например, при одинаковых k_1 различие резонансных полей СВ мод при перпендикулярной и параллельной ориентациях для трехслойной пленки (симметричные граничные условия) должно быть таким же, как для двухслойной, для которой граничные условия являются несимметричными. В то же время результаты проведенных экспериментов свидетельствуют об обратном. Наличие закрепления на обеих поверхностях слоя возбуждения приводит к удвоению величины рассогласования дисперсионных кривых (рис. 3). Этот факт, а также зависимость относительного рассогласования от толщины, свидетельствуют о том, что наблюдаемая анизотропия спектров СВР обусловлена причиной, указанной в пункте d), т.е. связана с действием области (областей) затухания на значения фазы гармонической спиновой волны, возбуждаемой СВЧ полем в слое с малым а, и тем самым на значения волновых чисел СВ мод.

Наборы возможных значений волновых чисел для перпендикулярной и параллельной ориентаций, полученные путем решения приведенных выше уравнений, показаны на рис. 4, *а*. Заметим, что во всех исследованных образцах в интервале магнитных полей, соответствующих наблюдаемому спектру СВР, слой закрепления при перпендикулярной ориентации является для спиновых волн реактивной (упругой) средой, а при параллельной



Рис. 4. *а* — графическое решение системы уравнений (1)–(8) при $h_1 = 0.69 \,\mu$ m. Цифры у точек пересечения кривой *1* — значения *n* для $\theta_H = 0$, кривой *2* — для 90°; *b* — распределение нормированной переменной намагниченности $m_i(z)/M_i$ (*i* — номер слоя) для первых пяти CB мод при $\theta_H = 0$ и 90°.

ориентации дисперсивной. В первом случае поле однородного резонанса в слое закрепления меньше, чем в слое возбуждения, во втором — наоборот, больше. Этим ситуациям соответствуют два различных набора волновых чисел k_{1n}^{\perp} и k_{1n}^{\parallel} , определенных по абсциссам точек пересечения кривых 1 и 2 с семейством кривых tg (k_1h_1) . Из рис. 4, *a* следует, что значения волнового числа для нулевой моды при одной и другой ориентациях практически одинаковы и близки к $\pi/2h_1$. С увеличением номера *n* различие фаз СВ мод на границе слоя возбуждения $\delta = k_{1n}^{\parallel}h_1 - k_{1n}^{\perp}h_1$ (при одинаковых *n*) начинает монотонно возрастать. И например, для моды с n = 8 это различие составляет уже $\sim \pi/2$. Из рис. 4, *a*



Рис. 5. Дисперсионные кривые $H_0 - H_n = f(k_1 h_1 / \pi)^2$ для двухслойных образцов с толщиной h_1 , μ m: I - 0.46, 2 - 0.69, 3 - 0.9, k_1 — расчетные значения волновых чисел, обозначения те же, что и на рис. 2 и 3.

также видно, что при параллельной ориентации **H** относительно пленки, когда слой закрепления является дисперсивной средой, значения $k_{1n}^{\parallel}h_1$ весьма близки к значениям $(n + 1/2)\pi$ и лишь незначительно превышают их. При перпендикулярной (слой закрепления реактивная среда), наоборот, происходит заметное отклонение $k_{1n}^{\perp}h_1$ от $(n+1/2)\pi$ в сторону меньших значений. Отсюда следует, что с увеличением *n* пространственные фазы CB мод на границе слоя возбуждения при различных ориентациях изменяются по-разному. На рис. 4, *b* приведены конфигурации нескольких первых мод для образца с $h_1 = 0.69 \,\mu$ m, которые иллюстрируют эти изменения.

Таким образом, возрастание с номером моды *n* разности пространственных фаз $\delta = k_{1n}^{\parallel} h_1 - k_{1n}^{\perp} h_1$ СВ мод, а следовательно, и значений волнового числа $\Delta k_1 = k_{1n}^{\parallel} - k_{1n}^{\perp} = \delta/h_1$ обусловливает наблюдаемое рассогласование дисперсионных кривых. Если значения волновых чисел СВ мод для перпендикулярной ориентации сдвинуть на Δk_1 , то дисперсионные кривые для обеих ориентаций совпадут между собой (рис. 5).

Как показывает расчет, разность волновых чисел $k_{1n}^{\parallel} - k_{1n}^{\perp}$ возрастает с увеличением их значений. А поскольку $k_{1n}^{\parallel}, k_{1n}^{\perp} \sim h_1^{-1}$, то при меньших толщинах слоя возбуждения h_1 возрастание $k_{1n}^{\parallel} - k_{1n}^{\perp}$ с номером моды должно происходить быстрее, т.е. для одинаковых волновых чисел с уменьшением толщины h_1 относительное влияние изменения фазы стоячей спиновой волны на значения k_{1n}^{\perp} и k_{1n}^{\parallel} возрастает. Данный фактор объясняет возрастание рассогласования дисперсионных кривых при уменьшении толщины слоя возбуждения (рис. 2).

Увеличение примерно в 2 раза величины рассогласования в трехслойных пленках по сравнению с двухслойными с аналогичными слоями возбуждения обусловлено удвоением действия описанного выше механизма. В этом случае на значения волнового числа влияют изменения фаз СВ мод как на одной, так и на другой границе слоя возбуждения.

Необходимо отметить, что, согласно результатам расчета, изменение знака поля анизотропии в слоях привело бы к обратному эффекту, т.е. наклон дисперсионной кривой при перпендикулярной ориентации (слой закрепления уже не реактивная, а дисперсивная среда) был бы больше, чем при параллельной.

Таким образом, на основе полученных результатов можно сделать следующие выводы.

 При промежуточных между перпендикулярным и параллельным (трудным и легким) направлениях намагничивания к существенному увеличению угла наклона дисперсионной кривой приводит изменение равновесной ориентации намагниченности, происходящее при регистрации спектра СВР.

2) Дополнительное влияние кроме доминирующего диссипативного механизма закрепления спинов, реактивных или дисперсивных, в зависимости от ориентации, свойств слоя закрепления приводит к изменению пространственных фаз стоячих спиновых волн на границе слоя возбуждения и, как следствие, к различию значений волновых чисел СВ мод с одинаковыми *n*. Данный фактор обусловливает рассогласование дисперсионных кривых при перпендикулярной и параллельной ориентациях постоянного магнитного поля относительно пленки.

Список литературы

- А.Г. Гуревич, Г.А. Мелков. Магнитные колебания и волны. Наука, М. (1994). 464 с.
- [2] M. Jirsa. Phys. Stat. Sol. B187, 125, 187 (1984).
- [3] Н.К. Даньшин, В.С. Деллалов, А.И. Линник, В.Ф. Шкарь. ФТТ 41, 8, 1452 (1999).
- [4] Н.М. Саланский, М.Ш. Ерухимов. Физические свойства и применение магнитных пленок. Наука, Новосибирск (1975). 224 с.
- [5] B. Hoekstra, R.P. van Stapele, J.M. Robertson. J. Appl. Phys. 48, 1, 382 (1977).
- [6] C.H. Wilts, S. Prasad. IEEE Trans. Magn. MAG-17, 2405 (1981).
- [7] Z.Q. Han, M. Pardavi-Horvath, P.E. Wigen, P. DeGasperis. J. Appl. Phys. 61, 8, 4256 (1987).
- [8] В.А. Игнатченко, Р.С. Исхаков. ЖЭТФ 72, 3, 1005 (1977).
- [9] Р.С. Исхаков, А.С. Чеканов, Л.А. Чеканова. ФТТ 32, 2, 441 (1990).
- [10] А.М. Зюзин, А.Г. Бажанов, В.В. Радайкин. ЖТФ 69, 11, 94 (1999).
- [11] А.М. Зюзин, А.Г. Бажанов. ЖЭТФ 111, 5, 1667 (1997).
- [12] А.М. Зюзин, Н.Н. Куделькин, В.В. Рандошкин, Р.В. Телеснин. Письма в ЖТФ 9, 3, 177 (1983).
- [13] А.М. Зюзин, А.Г. Бажанов, С.Н. Сабаев, С.С. Кидяев. ФТТ 42, 7, 1279 (2000).
- [14] А.М. Зюзин, В.В. Радайкин, А.Г. Бажанов. ЖТФ 67, 2, 35 (1997).
- [15] H. Makina, Y. Hidaka. Mat. Res. Bull 16, 8, 957 (1981).
- [16] В.Н. Ваньков, А.М. Зюзин. ЖТФ 62, 5, 119 (1992).